

**Requested
document:**

EP0464243 [click here to view the pdf document](#)

Oxygen sensor with semiconducting gallium oxide

Patent Number: EP0464243

Publication date: 1992-01-08

Inventor(s): FLEISCHER MAXIMILIAN DIPL-PHYS (DE); HANRIEDER WOLFGANG DIPL-PHYS (DE); MEIXNER HANS DR DIPL-PHYS (DE)

Applicant(s): SIEMENS AG (DE)

Requested Patent: ☐ [EP0464243](#), [B1](#)

Application Number: EP19900112780 19900704

Priority Number (s): EP19900112780 19900704


IPC Classification: G01N27/12

EC Classification: [G01N27/12](#)

Equivalents: DE59009246D

Cited Documents: [FR2393302](#); [EP0364315](#); [FR2298104](#); [EP0046989](#); [US3961248](#); [US4500412](#)

Abstract

An oxygen sensor comprises semiconducting gallium oxide, an electrically nonconducting substrate (1) on which gallium oxide is deposited, a contact electrode system (3) for measuring the electrical conductivity of the gallium oxide, a heating system for heating the oxygen sensor at a predetermined operating temperature, a protective casing which protects the oxygen sensor against external mechanical effects and a mounting base. The gallium oxide consists of an O₂- sensitive thin beta -Ga₂O₃ layer (2). To produce a catalytically inactive oxygen sensor, the contact electrode system (3) is completely coated with a deactivating layer. The contact electrodes are preferably arranged so as to be distributed two-dimensionally in an interdigitate system. The thin layer (2) is arranged on an aluminium-free support surface of the substrate (1). The substrate preferably consists of a BeO body. 

Data supplied from the esp@cenet database - I2



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



Veröffentlichungsnummer: **0 464 243 A1**

12

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21 Anmeldenummer: 90112780.3

51 Int. Cl.⁵: G01N 27/12

22 Anmeldetag: 04.07.90

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:
08.01.92 Patentblatt 92/02

94 Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE DK ES FR GB GR IT LI LU NL SE

71 Anmelder: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
Wittelsbacherplatz 2
W-8000 München 2(DE)

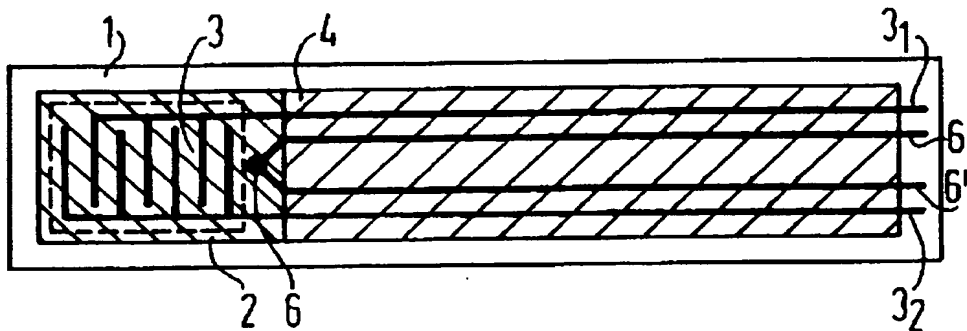
72 Erfinder: Fleischer, Maximilian, Dipl.-Phys.
Dachauerstrasse 265
W-8000 München 19(DE)
Erfinder: Hanrieder, Wolfgang, Dipl.-Phys.
Winkstrasse 8
W-8000 München 70(DE)
Erfinder: Meixner, Hans, Dr. Dipl.-Phys.
Max-Planck-Strasse 5
W-8013 Haar(DE)

64 Sauerstoffsensor mit halbleitendem Galliumoxid.

57 Ein Sauerstoffsensor mit halbleitendem Galliumoxid, mit einem elektrisch nichtleitenden Trägerkörper (1), auf den Galliumoxid aufgebracht ist, mit einer Kontaktelektroden-Anordnung (3) zum Messen der elektrischen Leitfähigkeit des Galliumoxids, einer Heizanordnung zum Heizen des Sauerstoffsensors bei einer vorbestimmten Betriebstemperatur, einer Schutzhülle, die den Sauerstoffsensor vor äußeren mechanischen Einflüssen schützt, und einem Befestigungssockel, bei dem das Galliumoxid aus einer

O₂-sensitive β -Ga₂O₃-Dünnschicht (2) besteht. Die Kontaktelektroden-Anordnung (3) ist zur Bildung eines katalytisch nichtaktiven Sauerstoffsensors mit einer deaktivierenden Schicht vollständig bedeckt. Die Kontaktelektroden sind vorzugsweise in interdigitaler Anordnung flächig verteilt angeordnet. Die Dünnschicht (2) ist auf einer aluminiumfreien Trägerfläche des Trägerkörpers (1) angeordnet. Der Trägerkörper besteht vorzugsweise aus einem BeO-Körper.

FIG 1



EP 0 464 243 A1

Die vorliegende Erfindung betrifft einen Sauerstoffsensor mit halbleitendem Galliumoxid, mit einem elektrisch nichtleitenden Trägerkörper, auf den Galliumoxid aufgebracht ist, mit einer Kontaktelektroden-Anordnung zum Messen der elektrischen Leitfähigkeit des Galliumoxids, einer Heizanordnung zum Heizen des Sauerstoffsensors bei einer vorbestimmten Betriebstemperatur, einer Schutzülle, die den Sauerstoffsensor vor äußeren mechanischen Einflüssen schützt, und einem Befestigungssockel.

Galliumoxid (Ga_2O_3) ist als Ausgangsmaterial für Hochtemperatur-Sauerstoffsensoren bekannt. Hergestellt wird es insbesondere in Form von keramischen, aus der Lösung gefällten Sinterproben. (Bulk-Material), vergl. z. B.: T. A. Jones, J. G. Firth, and B. Mann in "Sensors & Actuators", Vol. 8 (1985) S. 281 u. GB-PS 1529481.

Als Nachteile der mit diesem Bulk-Material hergestellten Sauerstoffsensoren sind im wesentlichen zu nennen:

- Aufwendiges nicht automatisierbares Herstellungsverfahren,
- schwere Reproduzierbarkeit der Sensoreigenschaften.

Bei hohen Temperaturen ($> 750^\circ\text{C}$) ändert sich der Sauerstoffgehalt des Materials Ga_2O_3 mit dem Sauerstoffpartialdruck der Umgebungsumgebung. Die elektrische Leitfähigkeit des halbleitenden Ga_2O_3 hängt vom Sauerstoffgehalt des Materials und somit vom Sauerstoffpartialdruck der Umgebungsumgebung ab.

Das Sensorsignal ist also die elektrische Leitfähigkeit des halbleitenden Ga_2O_3 . Die Sauerstoffdiffusion durch das Volumen des Materials beschränkt dabei die Ansprechgeschwindigkeit der Sensoren.

Das halbleitende Metalloxid besteht bei dem bekannten Sauerstoffsensor im wesentlichen aus Ga_2O_3 , aus dem ein kompakter, im wesentlichen kugelförmiger Widerstandskörper gebildet ist. Ein derartiger Widerstandskörper weist eine relativ hohe Erfassungs-Reaktionszeit auf, ist nur mit aufwendigen Verfahren herstellbar und stellt einen Sensor-Bestandteil dar, der die Fertigung von Sensoren mit gut reproduzierbaren Eigenschaften erschwert.

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Sauerstoffsensor der eingangs genannten Art und gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 zu schaffen, der langzeitstabil ist, kostengünstig herstellbar ist, eine relativ kleine Erfassungs-Reaktionszeit aufweist und im übrigen mit gut reproduzierbaren Eigenschaften gefertigt werden kann.

Zur Lösung dieser Aufgabe wird ein Sauerstoffsensor nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 vorgeschlagen, der die im kennzeichnenden Teil

des Patentanspruchs 1 angegebenen Merkmale aufweist.

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind durch die in den Unteransprüchen angegebenen Merkmale gekennzeichnet.

Ga_2O_3 ist bei Temperaturen über 400°C ein n-Halbleiter. Über 850°C steht der Sauerstoffgehalt des Materials in Wechselwirkung mit dem Sauerstoffgehalt der Umgebungsumgebung, so daß die spezifische elektrische Leitfähigkeit des Materials ein Maß für den gegenwärtig herrschenden Sauerstoffpartialdruck ist.

Erfindungsgemäß ist vorgesehen, daß das Galliumoxid als eine O_2 -sensitive β - Ga_2O_3 -Dünnschicht ausgebildet ist. Die Kontaktelektroden-Anordnung ist zur Bildung eines katalytisch nichtaktiven Sauerstoffsensors mit einer deaktivierenden Schicht vollständig bedeckt. Die Kontaktelektroden sind vorzugsweise in interdigitaler Anordnung flächig verteilt angeordnet. Die Dünnschicht ist auf einer aluminiumfreien Trägerfläche des Trägerkörpers angeordnet. Der Trägerkörper besteht vorzugsweise aus einem BeO -Körper. Der Trägerkörper kann auch mit einer Trägerabdeckschicht, vorzugsweise aus BeO , versehen sein, auf die die Dünnschicht aufgebracht ist. Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung ist vorgesehen, daß der Trägerkörper mit einer Trägerabdeckschicht aus SiO_2 versehen ist, auf die die Dünnschicht aufgebracht ist.

Auf den in der Dünnschicht standardmäßig verwendeten Al_2O_3 -Substraten hergestellte Ga_2O_3 -Dünnschichten sind bei Temperaturen um 900°C - 1000°C nicht stabil, wie eigene Untersuchungen gezeigt haben. Der Grund liegt in der chemischen Ähnlichkeit der Ga^{3+} und der Al^{3+} -Ionen, die zu einer Vermischung der beiden Substanzen führt.

Die Kontaktelektroden-Anordnung ist entweder direkt auf den Trägerkörper, auf die Trägerabdeckschicht aufgebracht oder in die Dünnschicht eingebettet.

Die Dicke der Dünnschicht beträgt zwischen $0,5$ bis $10\text{ }\mu\text{m}$, vorzugsweise 1 bis $2\text{ }\mu\text{m}$. Die Dicke der Kontaktelektroden beträgt zwischen 1 bis $10\text{ }\mu\text{m}$, vorzugsweise 2 bis $3\text{ }\mu\text{m}$. Vorzugsweise bestehen die Kontaktelektroden aus Pt. Sie können jedoch auch aus einer Legierung aus Platin-Metallen bestehen. Bei einer anderen erfindungsgemäßen Ausführungsform ist vorgesehen, daß die Kontaktelektroden aus einem metallisch leitenden Keramikwerkstoff bestehen.

In Nachbarschaft der Dünnschicht ist ein Temperatursensor auf dem Trägerkörper angeordnet, der die Ist-Betriebstemperatur erfaßt und dessen Erfassungssignal vorzugsweise zur Regelung auf die Soll-Betriebstemperatur verwendet wird.

Auf dem Trägerkörper kann eine Vielzahl von gleichartigen Sauerstoffsensoren und/oder anders-

artigen Sensoren angeordnet sein.

Eine vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung sieht vor, daß auf dem Trägerkörper paarweise zumindest ein sauerstoffdicht abgedeckter Sauerstoffsensor und ein nichtabgedeckter Sauerstoffsensor zur Erzielung einer Kompensation der Temperaturabhängigkeit der elektrischen Leitfähigkeit des Sauerstoffsensors angeordnet sind. Der sauerstoffdicht abgedeckte Sauerstoffsensor und der nichtabgedeckte Sauerstoffsensor bilden in Reihenschaltung einen Brückenweig einer Wheatstone-Brücke. Der andere Brückenweig ist dann aus einer Reihenschaltung zweier ohm'scher Widerstände gebildet, wobei die Potentialdifferenz zwischen den Verbindungspunkten zwischen den beiden Sauerstoffsensoren einerseits und den zwei ohm'schen Widerständen des anderen Brückenweiges andererseits als Ausgangssignal des Sauerstoffsensors.

Die Kontaktelektroden sind jeweils mit einer Anschlußelektrode, die vorzugsweise aus Pt besteht, verbunden, wobei diese Anschlußelektroden aus dem Sauerstoffsensor herausgeführt sind. Die Anschlußelektroden sind mit einer sauerstoffdichten Schicht abgedeckt.

Der Sauerstoffsensor ist bei einem Sauerstoffpartialdruck von minimal 10^{-14} bar ($\times 10^5$ Pa) an aufwärts zu betreiben.

Die Dünnschicht wird mittels der Heizanordnung auf eine Betriebstemperatur in einem Bereich von 750°C bis 1100°C , vorzugsweise 950°C bis 1000°C , aufgeheizt.

Zur Herstellung des Sauerstoffsensors ist erfindungsgemäß vorgesehen, daß die O_2 -sensitive Dünnschicht durch HF-Sputtern aufgebracht wird, wobei als Materialquelle ein Ga_2O_3 -Keramikarget dient, wobei der Trägerkörper auf eine Temperatur von vorzugsweise 500°C aufgeheizt wird und wobei dem Sputtergas Argon ein Sauerstoffanteil im Bereich von 10 bis 30, vorzugsweise 20 Volumenprozent, beigemischt wird.

Die Kontaktelektroden werden entweder mittels Siebdruck aufgebracht, oder sie werden mittels Aufputtern eines Pt-Films aufgebracht und mittels Photolithographie und anschließender Plasmaätzung strukturiert.

Zur Herstellung eines Sauerstoffsensors, dessen Kontaktelektroden in die Dünnschicht eingebettet sind, ist vorgesehen, daß in einem ersten Schritt eine erste Lage der O_2 -sensitiven Dünnschicht aufgebracht wird, daß in einem zweiten Schritt auf die erste Lage der O_2 -sensitiven Dünnschicht die Kontaktelektroden-Anordnung aufgebracht wird und daß in einem dritten Schritt eine zweite Lage der O_2 -sensitiven Dünnschicht zur Einbettung der Kontaktelektroden-Anordnung aufgebracht wird.

Zur Einstellung der Stöchiometrie der O_2 -sensitiven Dünnschicht und zum Erzielen der erforder-

lichen Kristallstruktur der O_2 -sensitiven Dünnschicht wird ein Temperprozeß an Luft bei Temperaturen um vorzugsweise 1100°C durchgeführt.

Im folgenden wird die Erfindung anhand mehrerer Figuren im einzelnen beschrieben.

Fig. 1 zeigt die Draufsicht eines Ausführungsbeispiels der Erfindung, bei dem zum Zwecke einer Betriebstemperaturregelung außer dem eigentlichen Sauerstoffsensor ein Thermoelement auf einem Trägerkörper angeordnet ist.

Fig. 2 zeigt die Draufsicht eines weiteren Ausführungsbeispiels der Erfindung, bei dem zum Zwecke einer Betriebstemperaturregelung außer dem eigentlichen Sauerstoffsensor eine Widerstandsschleife auf einem Trägerkörper angeordnet ist.

Fig. 3 zeigt die Draufsicht des in Fig. 1 gezeigten Trägerkörpers mit einer Heizanordnung zum Heizen des Sensors.

Fig. 4 zeigt eine Längsschnittansicht des Sauerstoffsensors gemäß einem Ausführungsbeispiel, bei dem eine Elektrodenanordnung direkt auf einem Trägerkörper sitzt und von einer sensitiven Schicht bedeckt ist.

Fig. 5 zeigt eine Längsschnittansicht des Sauerstoffsensors gemäß einem anderen Ausführungsbeispiel, bei dem eine Elektrodenanordnung auf einer Trägerkörper-Abdeckschicht sitzt und von einer sensitiven Schicht bedeckt ist.

Fig. 6 zeigt eine Längsschnittansicht des Sensors gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel, bei dem eine Elektrodenanordnung in eine auf einem Trägerkörper liegende sensitive Schicht eingebettet ist.

Fig. 7 zeigt die Draufsicht einer Anordnung gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel, bei dem ein gasdicht abgedeckter Sensor und ein nichtabgedeckter Sensor zum Zwecke der Kompensation der Temperaturabhängigkeit der elektrischen Leitfähigkeit des Sensors angeordnet sind.

Fig. 8 zeigt die Draufsicht eines Sensorgehäuses für den erfindungsgemäßen Sensor.

Fig. 9 zeigt die Längsschnittansicht des Sensorgehäuses gemäß Fig. 8.

Fig. 10 zeigt eine Kennlinienschar, die die Sauerstoffsensitivität einer Ga_2O_3 -Dünnschicht bei verschiedenen Be-

triebstemperaturen angibt, mit einem eingetragenen bevorzugten Betriebs-temperaturbereich.

Fig. 11 zeigt ein Diagramm, das die Stabilität des erfindungsgemäßen Sauerstoffsensors bei einer Betriebstemperatur von 1000 °C veranschaulicht.

Fig. 12 zeigt die Kennlinie der Sauerstoffsensitivität einer Ga_2O_3 -Dünnschicht bei 1000 °C über den Sauerstoffpartialdruckbereich, der dem gesamten Betriebsbereich des Sensors entspricht.

Wie bereits erläutert, zeigt Fig. 1 die Draufsicht eines Ausführungsbeispiels der Erfindung, bei dem zum Zwecke einer Betriebstemperatur außer dem eigentlichen Sauerstoffsensor ein Thermoelement 6 auf einem Trägerkörper 1 angeordnet ist. Das Thermoelement 6 ist zusammen mit der Kontaktelektroden-Anordnung 3, die eine interdigitale Struktur aufweist, auf der Ga_2O_3 -Dünnschicht 2 angeordnet. Zuleitungsbahnen 3₁ und 3₂, die die Kontaktelektroden-Anordnung 3 von der Außenseite des Sensors her anschließbar machen, sind auf dem Trägerkörper 1 angeordnet und von einer Schutzschicht 4 bedeckt. Zwischen dem Trägerkörper 1 und dieser Schutzschicht 4 liegen außerdem Leiterbahnen 6', 6'' zum Verbinden des Thermoelements 6 mit einer externen Meßanordnung.

Fig. 2 zeigt, wie bereits erläutert, die Draufsicht eines weiteren Ausführungsbeispiels der Erfindung, bei dem zum Zwecke einer Betriebstemperatur außer dem eigentlichen Sauerstoffsensor eine Widerstandsschleife 7 zusammen mit der Kontaktelektroden-Anordnung 3 auf der Ga_2O_3 -Dünnschicht 2 angeordnet ist. Die Widerstandsschleife 7 ist über Leiterbahnen kleinen elektrischen Widerstands 7', 7'' an eine externe Meßeinrichtung anschließbar. Sowohl das Thermoelement gemäß Fig. 1 als auch die Widerstandsschleife gemäß Fig. 2 sind derart angeordnet, daß sie die Betriebstemperatur der Ga_2O_3 -Dünnschicht 2 im Bereich der Kontaktelektroden-Anordnung 3 für Regelzwecke erfassen können.

Fig. 3 zeigt, wie bereits erläutert, die Draufsicht des in Fig. 1 gezeigten Trägerkörpers 1 mit einer Heizanordnung 5 zum Heizen der Dünnschicht 2 bei der erforderlichen Betriebstemperatur. Die Heizanordnung 5 ist über Leiterbahnen 5₁, 5₂ geringen Widerstands an eine externe Heizstromversorgung anschließbar. Diese Leiterbahnen 5₁, 5₂ und die Heizanordnung 5 selbst sind mit einer nichtleitenden Schutzschicht 4' bedeckt.

Wie bereits erläutert, zeigt Fig. 4 eine Längsschnittansicht des Sensors gemäß einem Ausführungsbeispiel, bei dem die Elektrodenanordnung 3, 3' direkt auf dem Trägerkörper 1 sitzt und von einer sensitiven Schicht, nämlich der Ga_2O_3 -Dünnschicht 2, bedeckt ist. Gemäß einem weiteren

Ausführungsbeispiel, das in Fig. 5 gezeigt ist, sitzt die Elektroden-Anordnung 3, 3' nicht unmittelbar auf dem Trägerkörper 1, sondern auf einer auf diesem aufgetragenen Trägerkörper-Abdeckschicht 1'. Die Kontaktanordnung 3, 3' ist wie in dem in Fig. 4 gezeigten Ausführungsbeispiel durch die sensitive Schicht, nämlich die Ga_2O_3 -Dünnschicht 2, bedeckt.

Fig. 6 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel, bei dem die Kontaktelektroden-Anordnung 3, 3' in die auf dem Trägerkörper 1 aufgetragene Ga_2O_3 -Dünnschicht 2 eingebettet ist.

Fig. 7 zeigt, wie bereits erläutert, die Draufsicht einer Anordnung gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel, bei dem ein gasdicht abgedeckter Sensor und ein nichtabgedeckter Sensor zum Zwecke der Kompensation der Temperaturabhängigkeit der elektrischen Leitfähigkeit des Sensors angeordnet sind. Bei diesem Ausführungsbeispiel wird kein Temperaturerfassungselement für den Sensor benötigt. Vielmehr kann durch Auswertung des Widerstandsverhältnis des mit einer Abdeckschicht 8 gasdicht abgedecktem Sensors 2₂ und des nichtabgedeckten Sensors 2₁ die Temperaturabhängigkeit des Widerstands der Sensorschichten in einem weiten Temperaturbereich ausgeglichen werden. Die beiden Sensoren 2₁ und 2₂ sind jeweils über Leiterbahnen 3₁, 3₁' bzw. 3₂, 3₂' mit nach außen führenden Anschlüssen verbunden. Diese Leiterbahnen niedrigen Widerstands sind jeweils individuell oder gemeinsam durch eine Schutzschicht 4 bedeckt.

Fig. 8 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines Sensorgehäuses 9 für den erfindungsgemäßen Sauerstoffsensor. Das Sensorgehäuse 9 weist Gaseinlaßschlitze 10 im Bereich des Sensors, einen Gewindebereich 11 zum Einschrauben des Sensorgehäuses 9 beispielsweise in einem Meßstutzen des Abgastrakts eines Pkw-Motors, ein Schraubteil 12, auf das ein Schraubenschlüssel gesetzt werden kann, eine Dichtkappe 13, die das Innere des Sensorgehäuses 9 gegen die umgebene Atmosphäre abdichtet und durch die die erforderlichen Anschlußleitungen 15 geführt sind, sowie eine Madenschraube 16 zum Fixieren des Trägerkörpers 1 innerhalb des Sensorgehäuses 9 auf. Fig. 9 zeigt einen Längsschnitt durch das Sensorgehäuse 9 gemäß Fig. 8. Wie ersichtlich, ist die Dichtkappe 13 mittels Schrauben 14 auf dem Schraubteil 12 befestigt. Die auf dem Trägerkörper 1 des Sauerstoffsensors angeordneten Leiterbahnen sind jeweils mit den betreffenden Anschlußleitungen 15 über Verschweißpunkte 17 verbunden.

Alternativ zu der Verwendung eines aluminiumfreien Trägerkörpers kann auch die Verwendung eines aluminiumhaltigen Trägerkörpers vorgesehen sein, der mit einer aluminiumfreien Diffusionsspererschicht vergütet ist.

Vorteile des erfindungsgemäßen Sauerstoffsensors:

- Da der Austausch des Sauerstoffs über Diffusionsvorgänge erfolgt, wird durch eine Reduzierung der Schichtdicke die Ansprechzeit des Sensors wesentlich verringert. Diese Reduzierung der Schichtdicke wird auf einfache Weise mittels des beschriebenen Dünnfilmprozesses erreicht.
- Das Herstellungsverfahren ermöglicht die Automatisierbarkeit von Herstellungsschritten und eine starke Verringerung des Materialverbrauchs an Ga_2O_3 (hohe Weltmarktpreise).
- Aufgrund erprobter Prozeßtechnologien wird eine hohe Reproduzierbarkeit der Sensoreigenschaften erreicht.
- In Planartechnologie ist Miniaturisierung und Integration mehrerer Komponenten (verschiedene Sensorelemente und Temperaturregelungs-Elemente) auf einem Trägerkörper möglich.
- Durch Verwendung aluminiumfreier Trägerkörper wird eine gute Langzeitstabilität der Dünnschicht-Sauerstoffsensoren erreicht.
- Der Sauerstoffsensor ist langzeitstabil und weist keine Querempfindlichkeit für reduzierende Gase auf.

Patentansprüche

1. Sauerstoffsensor mit halbleitendem Galliumoxid, mit einem elektrisch nichtleitenden Trägerkörper, auf dem Galliumoxid aufgebracht ist, mit einer Kontaktelektroden-Anordnung zum Messen der elektrischen Leitfähigkeit des Galliumoxids, einer Heizanordnung zum Heizen des Sauerstoffsensors bei einer vorbestimmten Betriebstemperatur, einer Schutzhülle, die den Sauerstoffsensor vor äußeren mechanischen Einflüssen schützt, und einem Befestigungssockel, **dadurch gekennzeichnet**, daß das Galliumoxid als eine O_2 -sensitive $\beta\text{-Ga}_2\text{O}_3$ -Dünnschicht (2) ausgebildet ist, daß die Kontaktelektroden-Anordnung (3) zur Bildung eines katalytisch nichtaktiven Sauerstoffsensors mit einer deaktivierenden Schicht vollständig bedeckt ist, daß die Kontaktelektroden vorzugsweise in interdigitaler Anordnung flächig verteilt angeordnet sind und daß die Dünnschicht (2) auf einer aluminiumfreien Trägerfläche des Trägerkörpers (1) angeordnet ist.
2. Sauerstoffsensor nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Trägerkörper aus einem BeO -Körper besteht.
3. Sauerstoffsensor nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Trägerkörper mit

einer Trägerabdeckschicht, vorzugsweise aus BeO , versehen ist, auf die die Dünnschicht aufgebracht ist.

4. Sauerstoffsensor nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Trägerkörper mit einer Trägerschicht aus SiO_2 versehen ist, auf die die Dünnschicht aufgebracht ist.
5. Sauerstoffsensor nach Anspruch 2, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Kontaktelektroden-Anordnung direkt auf den Trägerkörper aufgebracht ist.
6. Sauerstoffsensor nach Anspruch 3 oder 4, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Kontaktelektroden-Anordnung auf die Trägerabdeckschicht aufgebracht ist.
7. Sauerstoffsensor nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Kontaktelektroden-Anordnung in die Dünnschicht eingebettet ist.
8. Sauerstoffsensor nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Dicke der Dünnschicht zwischen 0,5 bis 10 μm , vorzugsweise 1 bis 2 μm , beträgt.
9. Sauerstoffsensor nach einem der Ansprüche 5 bis 7, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Dicke der Kontaktelektroden zwischen 1 bis 10 μm , vorzugsweise 2 bis 3 μm , beträgt.
10. Sauerstoffsensor nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Kontaktelektroden aus Pt bestehen.
11. Sauerstoffsensor nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Kontaktelektroden aus einer Legierung aus Platin-Metallen bestehen.
12. Sauerstoffsensor nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Kontaktelektroden aus einem elektrisch leitendem Keramikwerkstoff bestehen.
13. Sauerstoffsensor nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, daß in Nachbarschaft der Dünnschicht ein Temperatursensor auf dem Trägerkörper angeordnet ist, der die Ist-Betriebstemperatur erfaßt und dessen Erfassungssignal vorzugsweise zur Regelung auf die Soll-Betriebstemperatur verwendet wird.
14. Sauerstoffsensor nach einem der Ansprüche 1 - 13, **dadurch gekennzeichnet**, daß auf dem

Trägerkörper eine Vielzahl von gleichartigen Sauerstoffsensoren und/oder andersartigen Sensoren angeordnet ist.

15. Sauerstoffsensor nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, daß auf dem Trägerkörper paarweise zumindest ein sauerstoffdicht abgedeckter Sauerstoffsensor und ein nichtabgedeckter Sauerstoffsensor zur Erzielung einer Kompensation der Temperaturabhängigkeit der elektrischen Leitfähigkeit des Sauerstoffsensors angeordnet sind.

16. Sauerstoffsensor nach Anspruch 15, **dadurch gekennzeichnet**, daß der sauerstoffdicht abgedeckte Sauerstoffsensor und der nichtabgedeckte Sauerstoffsensor in Reihenschaltung einen Brückenweig einer Wheatstone-Brücke bilden und daß ein anderer Brückenweig aus einer Reihenschaltung zweier ohm'scher Widerstände gebildet ist, wobei die Potentialdifferenz zwischen den Verbindungspunkten zwischen den beiden Sauerstoffsensoren einerseits und den zwei ohm'schen Widerständen des anderen Brückenzweiges andererseits als Ausgangssignal des Sauerstoffsensors dient.

17. Sauerstoffsensor nach einem der Ansprüche 1 - 16, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Kontaktelektroden jeweils mit einer Anschlußelektrode, die vorzugsweise aus Pt besteht, verbunden sind, die aus dem Sauerstoffsensor herausgeführt sind und daß die Anschlußelektroden mit einer sauerstoffdichten Schutzschicht bedeckt sind.

18. Sauerstoffsensor nach einem der Ansprüche 1 - 17, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Sauerstoffsensor bei einem Sauerstoffpartialdruck von minimal 10^{-14} bar ($\times 10^5$ Pa) an aufwärts zu betreiben ist.

19. Verfahren zum Betrieb des Sauerstoffsensors nach einem der Ansprüche 1 bis 18, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Dünnschicht mittels der Heizanordnung auf eine Betriebstemperatur in einem Bereich von 750° bis 1100° C, vorzugsweise 950° - 1000° C, aufgeheizt wird.

20. Verfahren zur Herstellung des Sauerstoffsensors nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß die O_2 -sensitive Dünnschicht durch HF-Sputtern aufgebracht wird, wobei als Materialquelle ein Ga_2O_3 -Keramiktargat dient, wobei der Trägerkörper auf eine Temperatur von vorzugsweise 500° C aufgeheizt wird und wobei dem Sputtergas "Argon" ein Sauerstoff-

anteil im Bereich von 10 bis 30, vorzugsweise 20 Volumenprozent, beigemischt wird.

21. Verfahren zur Herstellung des Sauerstoffsensors nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß die sauerstoffsensitive Ga_2O_3 -Schicht mittels Siebdrucktechnologie aufgebracht wird.

22. Verfahren zur Herstellung des Sauerstoffsensors nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Kontaktelektroden mittels Siebdruck aufgebracht werden.

23. Verfahren zur Herstellung des Sauerstoffsensors nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Kontaktelektroden mittels Aufputtern eines Pt-Films aufgebracht und mittels Photolithographie und anschließender Plasmaätzung strukturiert werden.

24. Verfahren zur Herstellung des Sauerstoffsensors nach Anspruch 7, **dadurch gekennzeichnet**, daß in einem ersten Schritt eine erste Lage der O_2 -sensitiven Dünnschicht aufgebracht wird, daß in einem zweiten Schritt auf die erste Lage der O_2 -sensitiven Dünnschicht die Kontaktelektroden-Anordnung aufgebracht wird und daß in einem dritten Schritt eine zweite Lage der O_2 -sensitiven Dünnschicht zur Einbettung der Kontaktelektroden-Anordnung aufgebracht wird.

25. Verfahren zur Herstellung des Sauerstoffsensors nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß zur Einstellung der Stöchiometrie der O_2 -sensitiven Dünnschicht und zum Erzielen der erforderlichen Kristallstruktur der O_2 -sensitiven Dünnschicht ein Temperprozeß an Luft bei Temperaturen um vorzugsweise 1100° C durchgeführt wird.

FIG 1

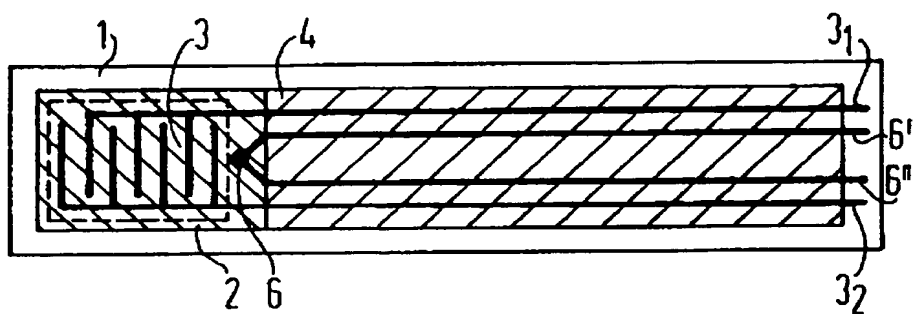


FIG 3

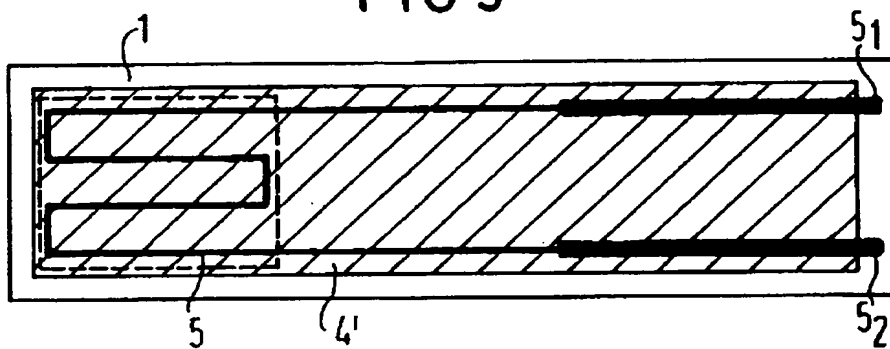


FIG 2

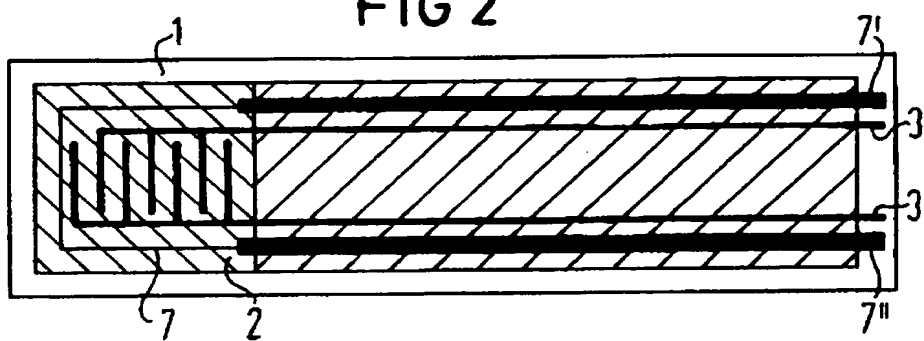


FIG 5

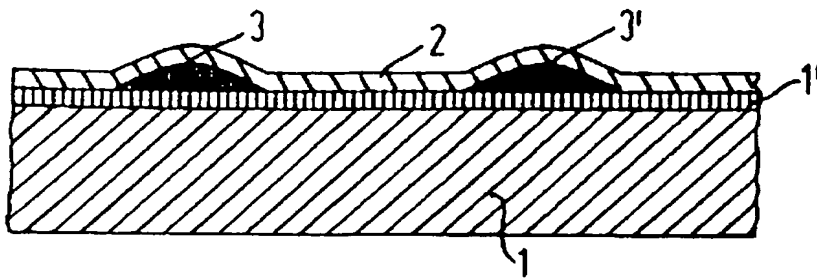


FIG 6

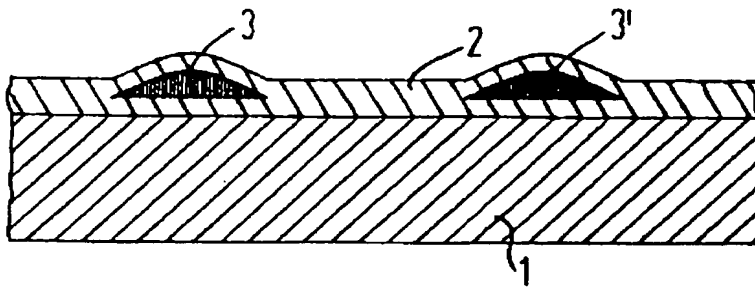


FIG 4

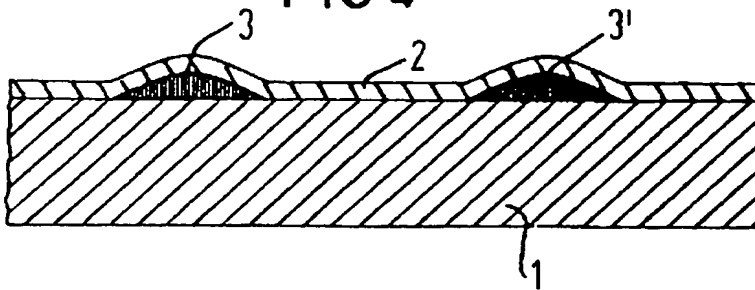


FIG 7

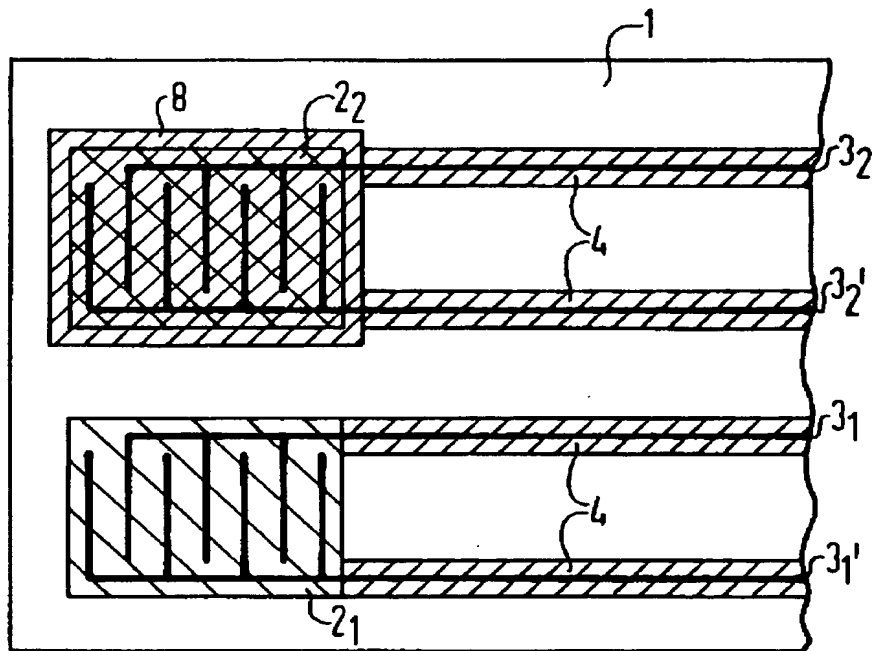


FIG 8

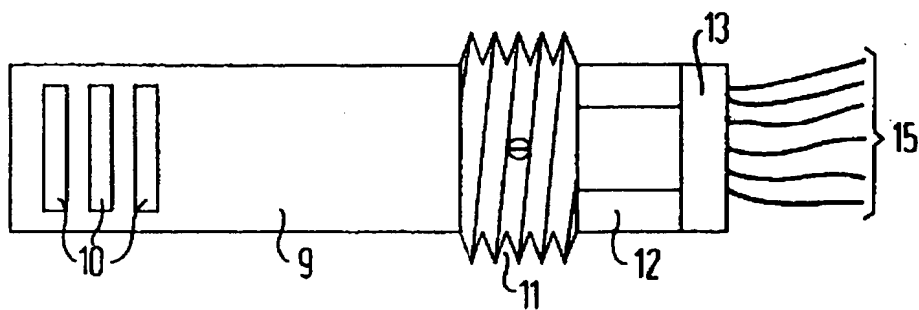


FIG 9

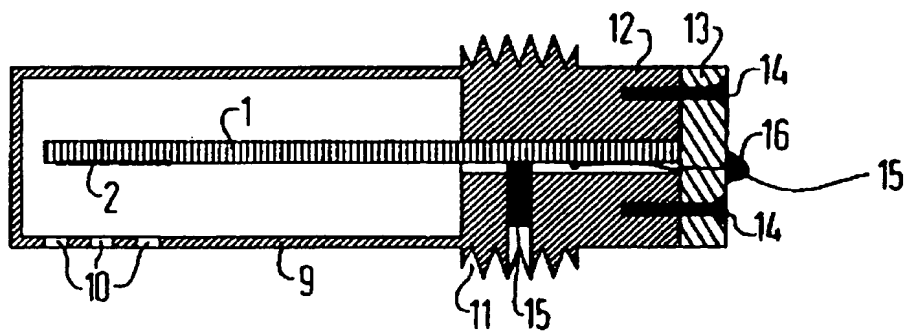


FIG 10

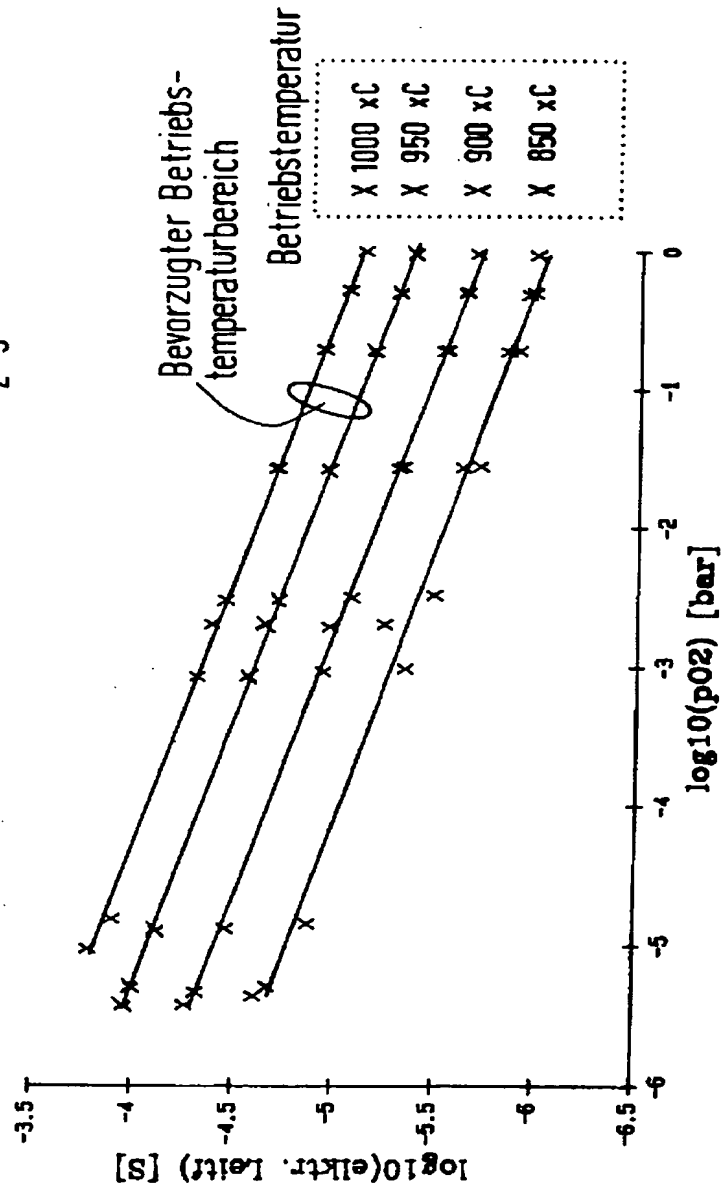
Sauerstoffsensitivität einer Ga_2O_3 -Dünnschicht

FIG 11

Langzeittest: Ga2O3/BeO

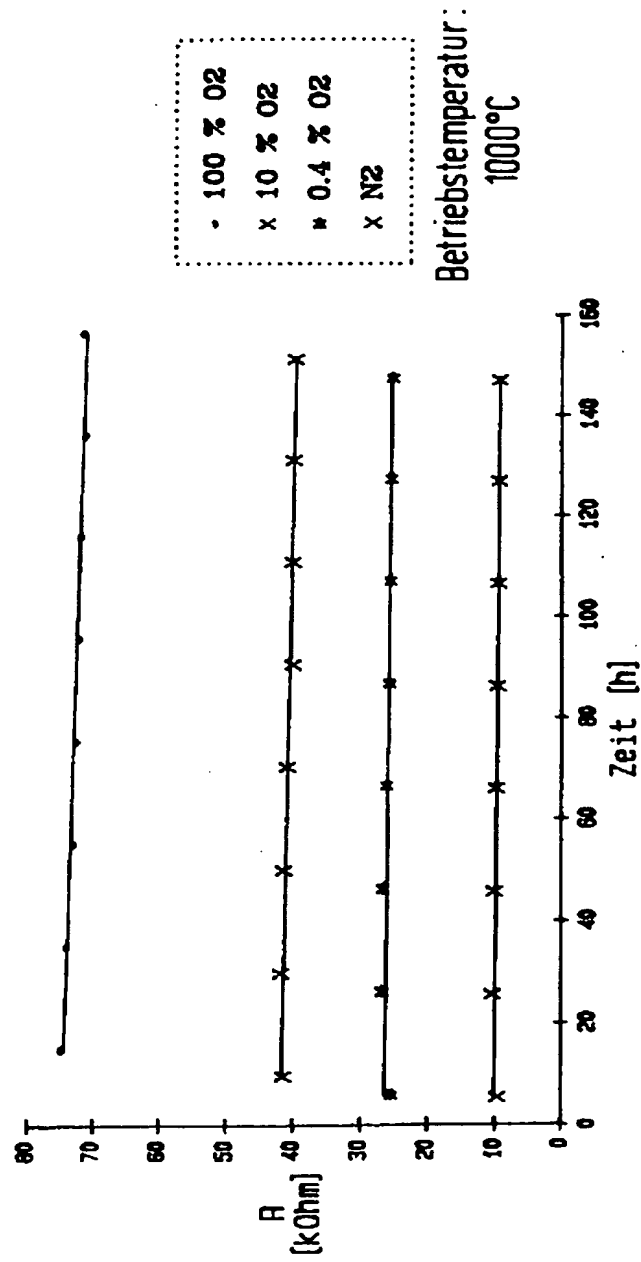
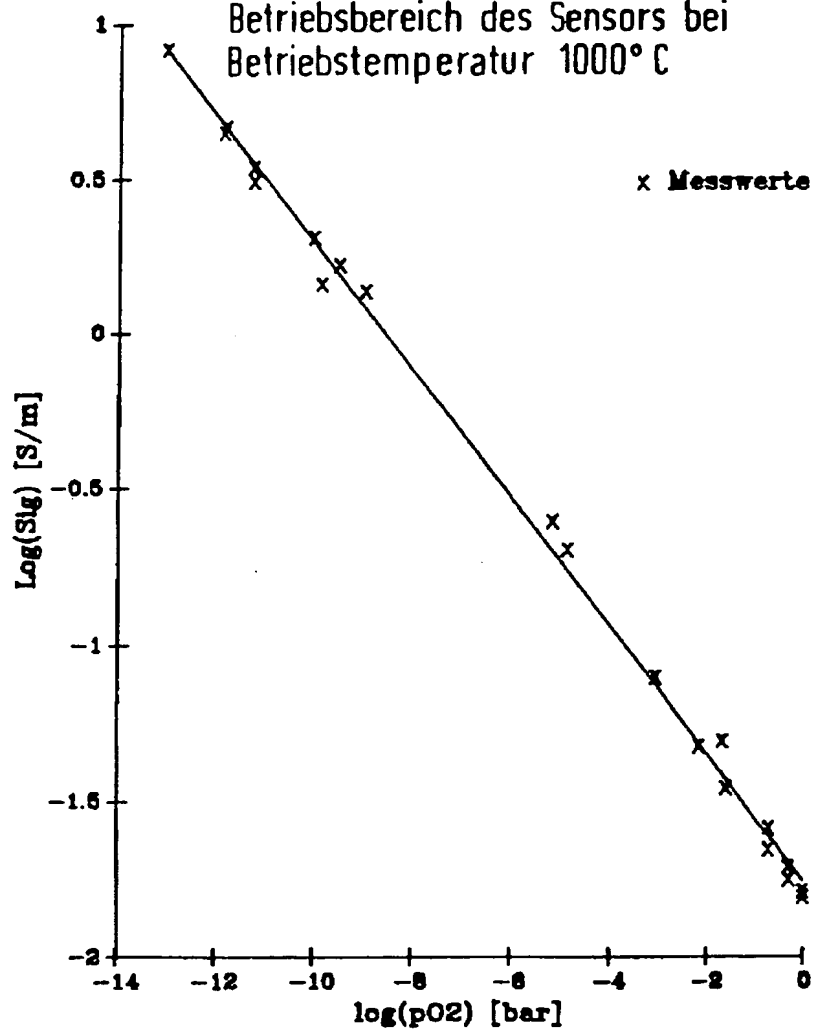


FIG 12

Sensorkennlinie über den gesamten
Betriebsbereich des Sensors bei
Betriebstemperatur 1000° C





Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 90 11 2780

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.5)
Y	FR-A-2 393 302 (FABBRICA ITALIANA MAGNETI MARELLI S.P.A.) * Seite 3, Zeile 7 - Seite 4, Zeile 25; Figur 1 *	1-3, 10-13,19, 21,22	G 01 N 27/12
Y	EP-A-0 384 315 (THOMSON-CSF) * Zusammenfassung; Spalte 7, Zeile 30 - Spalte 8, Zeile 12 *	1-3, 10-13,19, 21,22	
A	FR-A-2 298 104 (NATIONAL RESEARCH DEVELOPMENT CORP.) * Seite 2, Zeile 13 - Seite 6, Zeile 33 *; & GB-A-1529461 (Kat. D)	1,16	
A	EP-A-0 046 989 (SIEMENS AG) * Zusammenfassung; Seite 2, Zeile 7 - Seite 4, Zeile 25 *	20	
A	US-A-3 961 248 (M. KAWAMURA) * Zusammenfassung; Figuren 6,7 *	14,15	
A	US-A-4 500 412 (H. TAKAHASHI et al.) * Zusammenfassung *	8,9	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.5)
			G 01 N
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort Berlin		Abschlussdatum der Recherche 08 März 91	Prüfer BRISON O.P.
<div><div>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X: von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y: von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A: technologischer Hintergrund O: mündliche Offenbarung P: Zwischenliteratur T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze</div><div>E: älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D: in der Anmeldung angeführtes Dokument L: aus anderen Gründen angeführtes Dokument 8: Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</div></div>			